1P034 新規メソポーラスカーボンと分子クラスターがつくるナノ複合体の **固体電気化学特性** (名大院理¹,名大物質国際研², CREST³) 〇能見友貴¹,吉川浩史¹,阿波賀邦夫^{2,3}

Solid-state electrochemistry of nanohybrid materials between novel mesoporous carbons and molecular clusters

(Graduate School of Science, Nagoya Univ.¹, RCMS, Nagoya Univ.², CREST³) OYuki Noumi¹, Hirofumi Yoshikawa¹, Kunio Awaga^{2,3}

1. 序論

近年、環境問題やエネルギー問題から、高性能な二次電池の開発は大変重要な課題となっている。これまでに我々の研究室では、複数の金属イオンと有機配位子からなり、多電子の酸化還元能を有する分子クラスターを正極活物質に用いた『分子クラスター電池』の開発を試みてきた。その結果、安定な分子クラスターであるポリオキソメタレート(POM,

[PMo₁₂O₄₀]³)を正極活物質に用いた電池において、従来のリチ ウムイオン電池を超える容量が実現できることを見出した。¹¹ さらに、単層カーボンナノチューブ(SWNT)やグラフェンなど のナノカーボンに対して、POMをナノレベルで複合化した正極 活物質(図1)を用いることで、容量の増大に成功し、これがナ ノ複合化により誘起されたナノカーボンの電気二重層キャパシ タンス(EDLC)によるものであることを明らかにしてきた。^[2,3] 電極表面への電解質イオンの物理吸着を利用する EDLC は、電 極材料の構造や表面積に大きく依存するため、適切なナノカーボ ン材料を用いることで、その容量をより向上できる可能性がある と考えられる。



図 1. SWNT/POM ナノ複合体の TEM 像

本研究では、高表面積を有するナノカーボンとして多孔性配位高分子(MOF)を鋳型と したメソポーラスカーボン(MOF-Templated Carbon, MTC)およびグラフェン層間にシリカ ピラーを有するナノカーボン(ピラー化炭素)を作製し、POM とのナノ複合化を行うこと で、新規ナノ複合体の固体電気化学特性の検討を行ったので報告する。

2. MOF を鋳型としたメソポーラスカーボン (MTC)

MTC の作製手順を図 2 に示す。 文献に従い、硝酸亜鉛六水和物およ びテレフタル酸のジエチルホルム アミド混合溶液を 100 ℃ で 24 時間 加熱することにより、テレフタル酸 を架橋配位子とする亜鉛錯体





を合成した。IRMOF-1 を窒素ガス雰囲気下 10 °C/min の昇温速度で 550 °C まで加熱するこ とで炭化させた後、^[4] 塩酸で処理することにより酸化亜鉛を取り除き、MTC を得た。窒素 ガス吸着による表面積測定を行ったところ、SWNT では 600 m²g⁻¹、グラフェンでは 550 m²g⁻¹、 MTC では 1060 m²g⁻¹であり、高表面積なナノカーボンの作製に成功した。

この MTC を超音波処理によりトルエンに分散させ、そこへ POM のアセトニトリル溶液 をゆっくりと滴下した。得られた分散液を濾過後、真空下 70℃ で乾燥させることによりナ ノ複合体を得た。ナノ複合体の重量比は MTC: POM = 2:1とし、同定は IR 測定にて行った。 得られたナノ複合体を導電助剤および結着剤と 混合し、POM の重量が全体の 10 %となるように 正極を作製した。負極に金属リチウムを用いてコ インセル電池を作製し、電圧範囲 4.2-1.5 V、電流 値 1 mA で定電流充放電測定を行った。図 3 に各 電池 (POM, SWNT/POM ナノ複合体, グラフェン /POM ナノ複合体, MTC/POM ナノ複合体)の1サ イクル目の放電曲線(4.2-1.5 V)を示す。これよ り MTC/POM ナノ複合体が最も大きい容量を示す ことがわかった(図 3 赤線)。これは MTC の表面 積が最も大きいことによるものと思われ、高表面 積なナノカーボンの利用が重要であることが明らかとなった。



慎なノノカー ホンの利用が重安てのることが切りがとなりに

3. シリカピラーを有するナノカーボン(ピラー化炭素)

ピラー化炭素の作製 手順を図4に示す。文献 に従い、不活性ガス雰囲 気下で、酸化グラフェン (GO)をブチルアミン



に浸漬させた後、超音波 を用いてトルエンに分散し、トリクロロメチルシ ランを加えて 60 ℃ で 2 日間加熱することにより、

シリル化 GO を得た。得られたシリル化 GO を真 空下 600 ℃ で 5 時間加熱することにより、ピラー 化炭素を得た。^[5]

図 5 にピラー化炭素の粉末 X 線回折 (PXRD) および IR 測定の結果を示す。PXRD からは、GO に見られたグラフェン層間距離に由来するピーク が、シリル化 GO では低角側にシフトしており、IR よりケイ素含有基由来のピーク (1000 cm⁻¹ 付近 O-Si-O, 800 cm⁻¹ 付近 Si-OH) が観測されるため、 シリカ種のピラーによりグラフェン層間が拡張さ れたピラー化炭素の作製に成功したと考えられる。

なお、GO に対してシリル化反応を繰り返すこと により、シリカ種のピラー長が伸長していくため、 シリル化反応の繰り返し回数による構造制御の試 みや、得られたピラー化炭素と POM とのナノ複合 化およびその固体電気化学特性については当日報 告する。

図 4. ピラー化炭素の作製手順



4. 参考文献

- [1] H. Yoshikawa et al., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134, 4918-4924
- [2] H. Yoshikawa et al., Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 3471-3474
- [3] H. Yoshikawa et al., J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 3801-3807
- [4] S. J. Yang et al., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 7394-7397
- [5] Y. Matsuo et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids, 2012, 73, 1424-1427